

产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

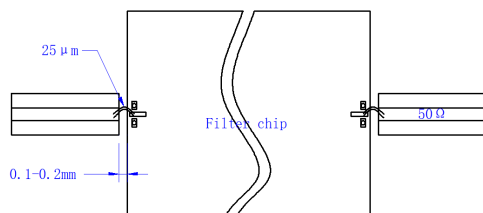
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8300	~	9300	MHz
中心损耗	/	/		3.7		dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	7.4&10.2	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	7.35&10.3	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	DC-6.85	GHz $\geq$	50			dB
带外抑制	10.45-25.5	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	$\leq$ 0.6ns
相位一致性	$\leq$ 5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



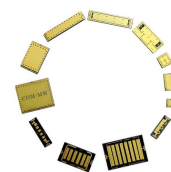
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 $\geq$ 3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 $\geq$ 0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用50 μ m $\times$ 10 μ m的金带或2根25 μ m的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在10GHz以上时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配。

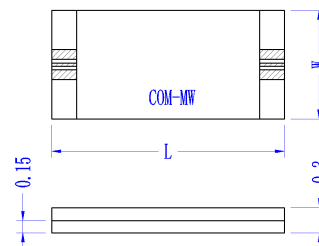
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图



外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	3.3	3.4	3.5

典型测试曲线图

